

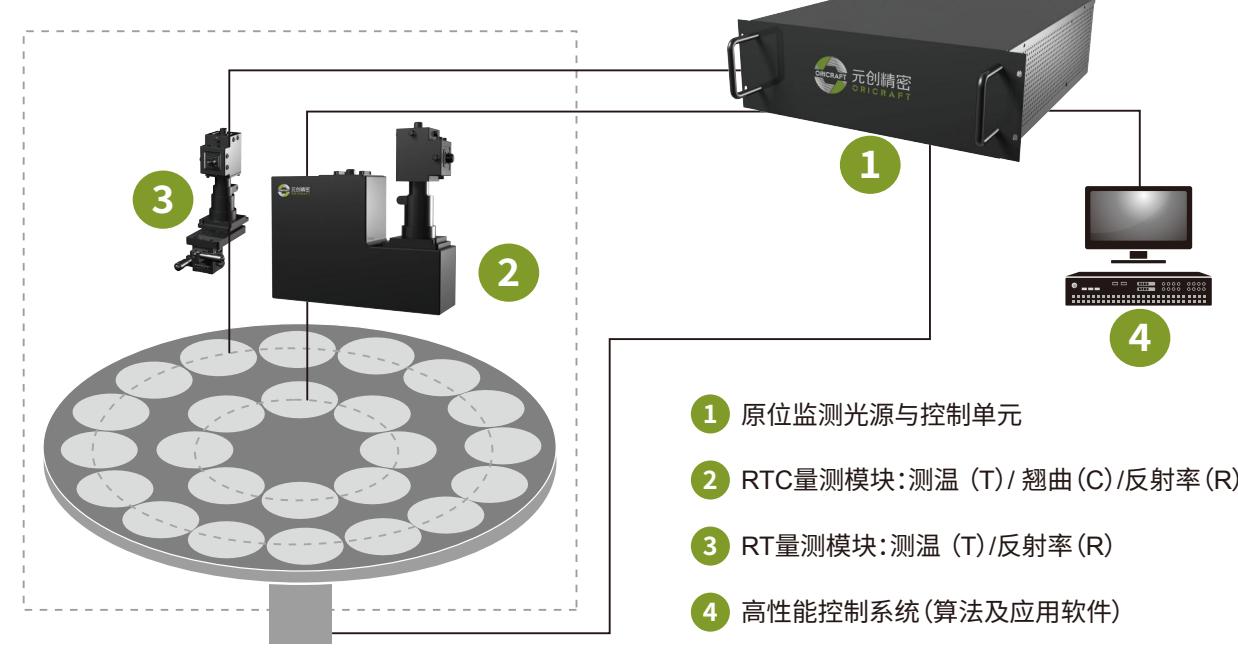
在线监测

MOCVD原位监测系统

MOCVD In-situ Monitoring System

VSI Link RTC-100

VSI Link RTC-100 三位一体，集成了高温计、反射率计和翘曲率计，可实现温度测量和加热控制、薄膜厚度和生长速率测量、材料应力及翘曲测量等功能。在 MOCVD 外延生长过程中，VSI Link RTC-100 对生长的各种参数和设备状况进行原位实时监测和控制，以便有效实现外延生长，避免废品，提高重现性和设备效能。



产品特点

- 非接触，原位实时监测，满足 7*24h 不间断运行
- 支持单片或多片晶圆测量
- 支持晶圆选择性生长速率分析
- 匹配发射率校正功能，实现温度实时补偿，确保准确的温度测量
- 可提供不同波长的反射率测量，满足不同沉积材料的生长速率分析需求
- 基于 TCP/IP 协议的软件接口，提供多种模拟信号输出方式，可集成到机台的终端系统，便于操作人员工艺分析、监控或优化



用户友好型软件，操作简易，测量全程可视化

技术指标

温度	波长	950nm
	测温范围	300 - 1200°C 或按需定制
	精度	±1.5°C
	可选定晶圆	是
反射率	波长	405±5nm, 推荐用于AlGaN/GaN/InGaN 633±5nm, 推荐用于AlGaAs/GaAs 950±5nm, 推荐用于InGaAs/InP
	光源寿命	>20,000小时
	生长率准确性	优于±1%
翘曲	采样频率	100Hz(3-20rpm), 2000Hz(20-100rpm)
	光源	405nm, 半导体激光器
	光源寿命	>10,000小时
	测量范围	-1000km ⁻¹ (convex) ~ 1000km ⁻¹ (concave)
	精度	±5km ⁻¹
	采样频率	20Hz